# Injection Beam Scheduling at SuperKEKB Complex through Damping Ring

Kazuro Furukawa<sup>(A)</sup>, Yoshihiro Funakoshi<sup>(A)</sup>, Mitsuo Kikuchi<sup>(A)</sup>, Eiji Kikutani<sup>(A)</sup>, Tatsuro Nakamura<sup>(A)</sup></sup>,</sup></sup>

Katsunobu Oide<sup>A)</sup>, Masanori Satoh<sup>A)</sup>, Masaaki Suetake<sup>A)</sup>, Tsuyoshi Suwada<sup>A)</sup>, Yoshiharu Yano<sup>A)</sup>

<sup>A)</sup>High Energy Accelerator Research Organization (KEK), 1–1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801

### Abstract

In the SuperKEKB project, a damping ring will be constructed at the middle of the linac in order to achieve a positron beam with lower emittance, which is required by the beam optics design for the higher luminosity. The injection and extraction scheme at the damping and main rings have to be designed under several criteria, which include the RF frequencies at the linac and the rings synchronized with large integers, dual beam bunches in a single linac pulse, and rising and falling times of the kickers. The harmonic number of the damping ring was chosen to allow wider range of buckets to be filled in the main ring. In order to enable the full bucket selection, a pulse-to-pulse LLRF adjustment system will be installed at the latter half of the linac, based on the cascaded event timing system. Pulse-to-pulse injection beam modulation (simultaneous injection) between SuperKEKB LER/HER, Photon Factory (PF) and PF Advanced Ring (PF-AR) is also discussed.

# SuperKEKB の入射ビームタイミング選択システム

# 1. はじめに

現在計画されている SuperKEKB 加速器計画におい ては、ルミノシティ向上のためナノビームオプションが 選択され、入射ビームにも低エミッタンスの要請が課さ れる<sup>[1]</sup>。そのため、入射器の中ほどにダンピングリン グを建設し、低エミッタンスの陽電子入射ビームを生成 する必要がある<sup>[2,3]</sup>。また、現在の入射器においては、 すでに KEKB 向けの 8-GeV 電子、3.5-GeV 陽電子と PF 放射光リング向けの 2.5-GeV 電子の 3 種類のビームを 50Hz パルス毎に切り換えて入射できる制御機構が実現 されているが<sup>[4,5]</sup>、SuperKEKB においてはビーム寿命 が短くなるため、PF-AR 放射光リングにも、4-GeV 陽 電子の高速パルス切り換え入射を行う必要があると思 われる。

入射効率を下げないために、これまで行われている、 繰り返し 50Hz のパルス内 2 バンチ加速も継続したいた め<sup>[6]</sup>、キッカーの立ち上がり時間を考えるとダンピン グリング内のビームタイミングも制限を受ける。さら に、メインリング入射タイミング誤差が数十ピコ秒しか 許されないため、ダンピングリングやメインリングと入 射器の多数のマイクロ波周波数の整数関係を維持する 必要もある<sup>[7]</sup>。これらの複雑な条件を検討すると、こ れまでは緩く結合させて構築していた、メインリングの 周長補正システムやビームバケット選択システムなどを 高速ビーム切り換え制御機構と密に結合させて動作さ せる必要があると思われる<sup>[8,9]</sup>。

SuperKEKB 計画における、これらの高速ビームタイ ミング制御機構の課題について、現在の KEKB 計画と 比較しながら検討する。

### 2. KEKB における高速ビーム切り換え制御

KEK の電子入射器を使って、効率的な同時入射を実現するためのビーム切り換えの際には、ひとつのパル

スも無駄にはできないので、約1kmにわたる機器に対 して20ミリ秒以内に確実に操作を行わなければならな い。電子入射器は、4つのリング加速器にビームを入射 しているが、切り換えるビームの性質は、エネルギーで 3倍以上、電流で部分的には100倍異なり、高速に切り 換える際の挑戦課題となった。

しかし、広域、高速、確実な制御機構については、こ れまで入射器の制御で用いてきた Ethernet と TCP/IP を 基礎とした広域制御だけでは、達成が困難かと思われ た。そこで、イベントシステムと呼ばれる制御機構を新 しく導入し、信頼性の高いタイミング信号伝送とそれに 同期した高速広域制御とを実現した<sup>[5,10]</sup>。

この装置内では、外部クロックに同期した 1GHz から 2.5GHz のデジタル信号を、FPGA と簡易信号発生器 で生成し、民生品となっている SFP (Small Form-factor Pluggable transceiver)で広域に光伝送することができる。 この信号は、50MHz から 125MHz の速度 (イベントレート)で送られるイベント及び同期データと呼ばれる短く 速い情報、毎秒 25~62.5 メガバイトの速度で最大 2 キ ロバイト送られる少し遅い情報、そしてタイミングク ロックを伝達するために用いられる<sup>[11]</sup>。制御ソフトウェ アは EPICS の枠組みのもとで構築している<sup>[12]</sup>。

2009 年の春から KEKB HER/LER と PF の入射について本格的な高速切り換え機構の運用を始め、次のような制御項目が実現されている。

- 1ヶ所のイベント生成ステーションと17ヶ所のイベント受信ステーション
- 電子銃の電圧とピコ秒タイミングの制御
- 13のマイクロ波発生装置での低電力マイクロ波の 制御
- 60の大電力マイクロ波のタイミング制御
- 12 のパルス電磁石オンオフ、タイミングの制御
- 100の入射器のビーム位置モニタのための24の
  ビーム位置測定ステーションの制御
- 100のビーム輸送路のビーム位置モニタのための

<sup>\*</sup>E-mail: <kazuro.furukawa@kek.jp>

4つのビーム位置測定ステーションの制御

- KEKB の電子と陽電子の入射位相の制御
- KEKB の電子と陽電子のセプタムタイミングの 制御
- KEKB の電子と陽電子のバケット選択の制御

これらの制御のために、20 ミリ秒のパルス毎に約 130 のアナログ・ディジタルパラメータが変更され、各リン グへの入射ビームを生成している。

通常の運転時には、PF リングからの入射ビームパル ス生成条件はあまり変わらないが、KEKB の HER と LER の入射については、頻繁に衝突条件の変更が行わ れることもあり、約10秒毎にビームモードパターンが 変更される。このような頻繁な条件の変更にも特に問題 なく対応し、連続して20ミリ秒毎にビームモードを切 り換えながら、同時入射を実現できている。図1に示す ように、ひとつの入射器を仮想的に3つの異なる加速器 として扱うことができる。この機構は SuperKEKB への入射においても主要な役割を果たすことになる。



図 1: KEKB HER/LER と PF の入射には 100 を超えるパラ メータを瞬時に切り換え、あたかも 3 つの異なる仮想的な加 速器をパルス毎に切り換えるような運転を行った。

## 3. SUPERKEKB に向けた入射器の増強

SuperKEKB 計画においては約40倍のルミノシティ を得るために、表1に示すような低エミッタンス大電 流のビームを入射する必要がある。電子についてはフォ トカソードを用いた RF 電子銃によってビームを生成し て入射する計画であるが、陽電子については生成陽電子 の捕獲セクションの改造と図2のようにダンピングリ ングの新設が必要となる。

表 1: KEKB と SuperKEKB のビーム特性の違い

	КЕКВ		SuperKEKB	
Beam	$e^-$	$e^+$	$e^-$	$e^+$
Energy	8GeV	3.5GeV	7GeV	4GeV
Charge	1nC	1nC	5nC	4nC
Emittance	$100 \mu m$	$2000 \mu m$	$20\mu m$	$10 \mu m$
Bunches	2	2	2	2

ダンピングリングでの陽電子のダンピングタイムは 12ms ほどなので、50Hz で陽電子を入射する場合は、ダ



図 2: 入射器の陽電子入射。SuperKEKB への入射にはダンピ ングリングが必要となる。

ンピングリングにおいて、20ms前のパルスで蓄積した 陽電子ビームを次のパルスで出射しながら新しい陽電 子ビームを入射蓄積する、というお手玉のようなビーム 操作を行うことになる。他のビームを切り換えながら 入射する場合、例えば電子 25Hz、陽電子 25Hz の場合 は、陽電子をダンピングリングに入射した後、次の電子 を加速するパルスでは陽電子はダンピングリングに蓄 積を続け、40ms後のパルスで出射するとともに、新し い陽電子ビームを蓄積する。

#### 3.1 RF 周波数の選択

元々入射器と KEKB リングの RF 周波数の間には歴 史的事情から表 2 のような少し複雑な整数関係がある が、SuperKEKB においても資源の有効利用のため同じ 周波数関係を維持することになる。そのためダンピング リングの周波数について検討してみる。

表 2: 入射器と KEKB の RF 周波数

	逓倍数	周波数
共通周波数	-	10.38546 MHz
Linac SHB1	×11	114.24 MHz
Linac SHB2	$\times 55$	571.2 MHz
Linac Main	×275	2856 MHz
KEKB Ring	$\times 49$	508.8873 MHz

入射効率を上げるために、ひとつのパルス内に2バン チを加速するスキームは SuperKEKB でも必要となる。 ふたつのバンチの間隔は共通周波数 10.38MHz によって 決定され、96.3ns となっている。このことから、効率を 失わないためには、ダンピングリングの周波数との間に も少なくとも現在と同じ共通周波数を持つ必要がある。 そのため、他の施設で使用されることのある 476MHz や 714MHz などは採用できない。入射器のサブハーモニッ クバンチャ (SHB) で使用されている 571.2MHz も選択 可能ではあるが、CW クライストロン等の資源を考え ると KEKB メインリングで使用されている 508.89MHz を選択することがもっとも適当であると考えられる。

### 3.2 ダンピングリングのハーモニック数

次にダンピングリングの大きさを検討してみる。ダ ンピングリングでは先に書いたようにお手玉のように 陽電子バンチ出し入れするために、2バンチずつの2パ ルス、合計4バンチを図3のように置ける間隔が必要 となる。ここで、パルス内の2バンチの間隔は96.3ns で、その2バンチを組としたパルスの間隔は入出射キッ カーの立ち上がり・立ち下がりから決まり、現実的には 100ns 程度以上と考える。このことからハーモニック数 は少なくとも約200以上必要となる。



図 3: ダンピングリング内の2バンチ×2パルスの配置。

KEKB においては、メインリングの RF 周波数が基 本周波数の 49 倍であり、ハーモニック数 5120 と共通 約数を持たないため、49 周つまり約 500µs 待つ間に必 ずどのバケットにでも入射が可能となる。SuperKEKB においては条件が厳しくなり、バケット選択の自由度が 狭まる可能性があるが、50Hz パルスモジュレータ電源 の安定度を考えると、少なくとも最大待ち時間 2ms の うちに入射を行う必要があると思われる。また、RF 位 相をあまり変調せずに、SuperKEKB メインリングのバ ケットをできるだけ自由に選択できるためには、ダンピ ングリングのハーモニック数がメインリングのハーモ ニック数 5120 と単純な整数関係を持たないことが好ま しい。

このようなことを考慮し、ダンピングリングから 2ms 以内に出射し、できるだけ多数のメインリングバケット に入射できる条件を 200 以上のハーモニック数で探して みると、ハーモニック数 230 のときに 5120 のうち 3000 以上のバケットに入射できることがわかった。実は、ダ ンピングリングや入射器の RF 位相をパルス毎に変調す れば全てのバケットを選択することが可能で、実際には どのバケットでも選択できる必要があるので RF 位相の 変調は必須ではあるが、コミッショニングの容易さを考 えてこのハーモニック数 230 を選択することが適当で あると考えられる。

入射器のパルス毎の RF 位相変調は他のビームの切 り換えのためにいずれにせよ必要であり、現在でも行っ ている。しかし、現在は再現性が保証されれば問題はな いが、SuperKEKB 向けの新しい仕組みでは 360 度の直 線性が重要になり、低電力 RF 系の再較正が必要になる と考えられる。ダンピングリングの RF 位相を変調する 方法もあるが、陽電子バンチのお手玉を考えると、パル ス間の依存関係が増え、得策でないと思われる。

#### 3.3 イベントタイミング制御

KEKB においては、1 系統のイベントタイミングシ ステムを用い、バケット選択システムもタイミング信号 とビームの種類の情報を交換するだけの独立のシステム であったが、上に述べたような状況に対応するために、 多少複雑な構成が必要になると思われる。

これまでは、パルス間の依存関係は、数種類のパル スモジュレータ電源の安定度に伴う繰り返し変更につ いての制限だけであったが、ダンピングリングの陽電子 ビームのお手玉のためにパルス間の依存関係が増えてし まう。特に、陽電子ビームの入射頻度が低い場合には、 ダンピングリングの入射と出射の間で 20ms × n の正確 なタイミング管理が必要となる。このため、入射器の前 半と後半に分けた 2 系統のイベント制御システムを構 成することを検討している。

また、メインリングでどのバケットを選択するかに よって、ダンピングリングでのバケット選択、入出射タ イミングや入射器後半の RF 位相制御がパルスをまたい で必要となるため、バケット選択システムはイベント制 御システムと一体とする運用が必要と思われる。

### 4. PF-AR の入射

PFの入射路は KEKB と独立であったため、エネル ギーが大きく異なるが、パルス偏向電磁石の増設により、 高速ビーム切り換えによる同時入射が可能であった。し かし、PF-ARの入射路は SuperKEKB と共通となるため、 同時入射は簡単にはできない。ところで、SuperKEKB のビーム寿命は 10 分程度と短いため、PF-AR への通常 切り換え入射を行うと、偏向電磁石の標準化を伴い大き な時間を必要とする。これは Belle2 の衝突実験の中断 を意味する。

そこで、現在の PF-AR への 3GeV 電子入射の代わり に 4GeV の陽電子入射の可能性が検討されている。電 子のエネルギーは 7GeV と高いために入射機構の改造 が大規模になり現実的ではないが、陽電子のエネルギー は 4GeV なので改造が小規模ですむことになる。PF-AR の実験エネルギーは 6.5GeV であるためトップアップ運 転はできないが、高速ビーム切り換えが可能となれば、 少なくとも Belle2 の衝突実験の中断は避けることがで きる。

しかし、検討課題はいくつかあり、例えば、リングの RF 周波数を決める周長補正について、PF-AR のそれは SuperKEKB のそれとは独立に行われる。PF-AR の周長 補正の方が 10 倍ほど変化が大きく、また、入射器の RF 周波数は SuperKEKB と整数関係を持つため、PF-AR と は整数関係に無い。

陽電子を使用するために、パルス偏向電磁石の増設 を最低限にするためにはダンピングリングを通して入射 することになる。偶然の入射タイミングを探す場合は、 PF 入射では SHB の 114MHz と旋回周波数の偶然の同 期を探してきたが、ダンピングリングを通して PF-AR に入射する場合は、ダンピングリングと入射器の共通周 波数である 10.38MHz と PF-AR 旋回周波数の偶然の同 期を探すことになり、入射確率が下がる可能性がある。 さらに、これが可能となるためには、電子銃のタイミン グからダンピングリングの旋回周波数との同期を考慮 しなくてはならない。しかし、パルスをまたいでタイミ ングを作るとしたら整数関係の無い RF 間では不可能と なる。PF-AR の入射時には PF-AR の周波数を固定する などの方策があるかと思われるが、単純ではない。

また、Belle2の実験によっては SuperKEKB の衝突エ ネルギーの変更が予想され、それに伴って入射陽電子 のエネルギーが変更されるので、PF-AR の入射エネル ギーを変更しなくてはならない。不可能ではないと思わ れるものの、どのような方針をとるのが適当であるか検 討中である。

# 5. まとめ

SuperKEKBの入射について、ダンピングリングを含 めて検討を加えた。検討結果も利用してダンピングリン グの設計が進んでいる。イベントタイミング制御につい てはパルスをまたがる制御についての工夫と、低電力 RF 制御についての再較正などが必要であるが、原理的 な困難はなさそうである。PF-AR を含めた同時入射機 構はさらに検討を進めているところである。全体として 入射器運転の効率を高めながら、信頼性も失わない入射 機構の設計を進めていきたい。

## 参考文献

- [1] M. Masuzawa, "Next Generation B-factories", *Proc. IPAC2010*, Kyoto, Japan, 2010, p. 4764.
- [2] T. Kamitani *et al.*, "SuperKEKB に向けた KEKB 入射ライ ナックの改造計画", *these proceedings*.
- [3] M. Kikuchi *et al.*, "Design of Positron Damping Ring for Super-KEKB", *Proc. IPAC2010*, Kyoto, Japan, 2010, p. 1641.
- [4] M. Satoh et al., "高速ビームモード切り替えのための KEK 入射器アップグレード現状報告", Proc. 5th Annual Meeting of Particle Accelerator Society, Hiroshima, 2008, p. 821.
- [5] K. Furukawa *et al.*, "New Event-based Control System for Simultaneous Top-up Operation at KEKB and PF", *Proc. ICALEPCS2009*, Kobe, Japan, 2009, THP052.
- [6] K. Furukawa *et al.*, "Beam Feedback Systems and BPM Read-Out System for the Two-Bunch Acceleration at the KEKB Linac", *Proc. ICALEPCS2001*, San Jose, USA., 2001, p. 266.
- [7] K. Furukawa *et al.*, "The Timing System of KEKB 8-GeV Linac", *Proc. ICALEPCS2003*, Gyeongju, Korea, 2003, p. 130.
- [8] E. Kikutani *et al.*, "KEKB Bucket Selection System, Present and Future", *these proceedings*.
- [9] K. Furukawa *et al.*, "Pulse-to-pulse Beam Modulation and Event-based Beam Feedback Systems at KEKB Linac", *Proc. IPAC2010*, Kyoto, Japan, 2010, p.1271.
- [10] T. Kudou et al., "KEK LINAC におけるイベントタイミン グシステム", these proceedings.
- [11] <http://www.mrf.fi/>.
- [12] <http://www.aps.anl.gov/epics/>.